

2645

05.03.01

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

RECD 20 APR 2001

WIPO

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日

Date of Application:

2000年 3月 6日

JP01/1672

出願番号

Application Number:

特願2000-059710

出願人

Applicant(s):

ローム株式会社

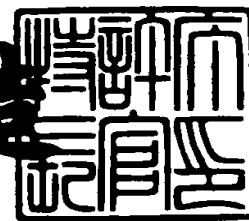
E.V.

PRIORITY
DOCUMENTSUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2001年 4月 6日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3026527

【書類名】 特許願

【整理番号】 99-00493

【提出日】 平成12年 3月 6日

【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿

【国際特許分類】 H01L 29/78

【発明者】

 【住所又は居所】 京都市右京区西院溝崎町 2 1 番地 ローム株式会社内

 【氏名】 東田 祥史

【発明者】

 【住所又は居所】 京都市右京区西院溝崎町 2 1 番地 ローム株式会社内

 【氏名】 高石 昌

【特許出願人】

 【識別番号】 000116024

 【氏名又は名称】 ローム株式会社

 【代表者】 佐藤 研一郎

【代理人】

 【識別番号】 100098464

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 河村 洸

 【電話番号】 06-6303-1910

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 042974

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 9506043

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 半導体層に並列接続された複数のトランジスタセルが配列されることにより形成される絶縁ゲート電界効果トランジスタと、該トランジスタのゲートおよびソース間に接続され、該ゲートおよびソース間に印加される一定電圧以上の入力をブレイクダウンさせる保護ダイオードとを有する半導体装置であって、前記保護ダイオードが、前記配列されるトランジスタセルより外周側の絶縁膜上に設けられるポリシリコン膜にリング状の p 形層と n 形層とが平面的に交互に設けられることにより形成され、かつ、前記 p 形層または n 形層の最外周の層に、金属膜からなりゲート電極パッドと連続的に形成されると共に、リング状に設けられるゲート配線がコンタクトされ、前記 p 形層または n 形層の最内周の層に、金属膜からなるソース配線がコンタクトされてなる半導体装置。

【請求項 2】 前記配列されるトランジスタセルの前記保護ダイオードに一番近い側に半導体基板と異なる導電形の拡散領域が形成され、前記保護ダイオードの最内周の層にコンタクトされる前記ソース配線が、該拡散領域にもコンタクトされてなる請求項 1 記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、MOSFET や絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ (IGBT) のゲート・ソース間などに保護ダイオードが接続されるような半導体装置に関する。さらに詳しくは、チップ面積を大きくすることなく、保護ダイオードの挿入抵抗を小さくし、静電破壊耐量を大きくすることができる半導体装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、たとえば縦型 MOSFET は、スイッチングスピードが速く、大出力のスイッチングデバイスとして用いられているが、ゲート絶縁膜を薄膜化することにより、ゲートしきい値電圧を下げる方向にある。この絶縁膜が薄くなると静電

気などの小さなエネルギーでも容易に絶縁破壊する。そのため、ゲート・ソース間に保護ダイオードを挿入して、その保護ダイオードで静電気を放電させる構造が用いられている。この保護ダイオードは、たとえばポリシリコン膜からなるゲート電極パッドの外周部分にpn接合が形成されて双方向のツェナーダイオードとされ、ゲートとソースとの間に接続されるもので、このような保護ダイオードを設ける構造の縦型MOSFETの一例が図6(a)に断面図で示されている。

【0003】

すなわち、たとえば n^+ 形の半導体基板21a上に、ドレイン領域とするn形の半導体層（エピタキシャル成長層）21がエピタキシャル成長され、その表面側にp形不純物を拡散することによりp形のボディ領域22が形成され、そのボディ領域22の外周部に n^+ 形のソース領域23が形成されている。ボディ領域22の端部およびその外側に位置する半導体層21の表面側にゲート酸化膜24を介してゲート電極25が設けられている。そして、ソース領域23と接続するように層間絶縁膜26を介してA1などによりソース電極（ソース配線）27が形成され、半導体基板21aの裏面に図示しないドレイン電極が形成されることにより、FET部20が形成されている。

【0004】

このボディ領域22が図6(b)に平面図で示されるように、マトリクス状に形成され、トランジスタセルが複数個形成されることにより、大電流に対応するパワーMOSFETが形成されている。

【0005】

また、保護ダイオード部30は、n形半導体層21にボディ領域22と同様に拡散により形成されたp形領域31の表面に絶縁膜32を介してポリシリコン膜からなるゲート電極パッド33が形成され、図7(a)にゲート電極パッド33の平面説明図が示されるように、そのゲート電極パッド33の外周部にn形層33aとp形層33bとが、交互に形成されることにより、npnpnの接続構造として最外周のn形層33aが前述のソース電極27と接続されている。その結果、図7(b)に等価回路図が示されるように、FETのゲートGとソースS間に双方向のツェナーダイオードZDからなる保護ダイオード30が形成されてい

る。なお、図6において、35はポリシリコンからなるゲート電極パッド33と接続して形成されたA1などの金属からなるボンディング用のゲート電極パッドおよびゲート配線である。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

前述のように、従来の保護ダイオード部は、ポリシリコンからなるゲート電極パッドの外周部に設けられる構造になっている。ゲート電極パッドの外周部に設けられる構造では、保護ダイオード部の幅（pn接合方向に直角な方向の長さで、ゲート電極パッドの外周長さ）を十分に大きくすることができない。そのため、保護ダイオード部の直列抵抗が増大して十分に耐圧を向上させることができず、ゲート電極パッドを大きくすると、トランジスタセルの部分が狭くなって特性が低下するか、チップ面積を大きくしなければならないという問題がある。

【0007】

本発明は、このような問題を解決するためになされたもので、チップ面積を大きくすることなく、チップの空いている外周部分を利用しながら、直列抵抗が小さく、かつ、十分に保護機能を果たすことができる保護ダイオードを有する半導体装置を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、縦型MOSFETなどのサージなどに対する耐圧を向上させるため、鋭意検討を重ねた結果、ゲート・ソース間にツェナーダイオードなどの保護ダイオードを挿入しても、そのゲート・ソース間の直列抵抗が大きくなると、保護ダイオードを介して放電する前に、ゲート絶縁膜が破壊して、十分にその機能を果たし得ないことを見出した。そして、できるだけ幅広に（pn接合方向に対して直角方向の長さを長く）形成すると共に、その接続構造も半導体層などを介さないで、直接金属配線により接続し、抵抗成分をもたせない構造にすることにより、始めて耐圧を向上させることができることを見出した。

【0009】

本発明の半導体装置は、半導体層に並列接続された複数個のトランジスタセル

が配列されることにより形成される絶縁ゲート電界効果トランジスタと、該トランジスタのゲートおよびソース間に接続され、該ゲートおよびソース間に印加される一定電圧以上の入力をブレイクダウンさせる保護ダイオードとを有する半導体装置であって、前記保護ダイオードが、前記配列されるトランジスタセルより外周側の絶縁膜上に設けられるポリシリコン膜にリング状のp形層とn形層とが平面的に交互に設けられることにより形成され、かつ、前記p形層またはn形層の最外周の層に、金属膜からなりゲート電極パッドと連続的に形成されると共に、リング状に設けられるゲート配線がコンタクトされ、前記p形層またはn形層の最内周の層に、金属膜からなるソース配線がコンタクトされることにより形成されている。

【0010】

この構造にすることにより、配列されるトランジスタセルの外周側は、半導体チップの外周部になり、半導体チップには、通常セル活性領域の周囲またはチップの外周部には空乏層の終端部を確保するためのスペースがあり、そのスペース部分の絶縁膜上に電極用のポリシリコン膜が設けられて保護ダイオードが形成されている。そのため、チップ面積を大きくすることなく、従来の空きスペースを利用して保護ダイオードが形成されている。

【0011】

しかも、チップの外周部にリング状に保護ダイオードが形成されることにより、その周長（pn接合方向に直角の方向の長さ）はチップサイズに対してほぼ最大に形成され、pn接合方向の直列抵抗を非常に小さくすることができる。さらに、その保護ダイオードの最外周の半導体層に金属膜からなるゲート配線が接続されると共に、最内周の半導体層に金属膜からなるソース配線が接続されていることにより、保護ダイオードの接続部に半導体の拡散領域やポリシリコン膜を使用していないため、非常に低抵抗になっている。その結果、チップ面積を大きくすることなく、非常に耐圧に優れた保護ダイオードを内蔵し、静電気などに対する十分な保護をすることができる。

【0012】

前記配列されるトランジスタセルの前記保護ダイオードに一番近い側に半導体

基板と異なる導電形の拡散領域が形成され、前記保護ダイオードの最内周の層にコンタクトされる前記ソース配線が、該拡散領域にもコンタクトされていることにより、フィールドプレートとなって、一層トランジスタの耐圧が向上する。

【0013】

【発明の実施の形態】

つぎに、図面を参照しながら本発明の半導体装置について説明をする。本発明による半導体装置は、図1にその一実施形態である縦型MOSFETのチップ外周部の断面説明図（図1（b）のA-A断面）とチップ全体の平面説明図が示されるように、半導体層4に複数個のトランジスタセルTが配列されて形成されている。そして、その配列される複数個のトランジスタセルTより外周側（チップ端部側）の絶縁膜6上にポリシリコン膜が設けられ、そのポリシリコン膜にリング状のp形層1bとn形層1aとが平面的に交互に形成されることにより、保護ダイオード1が形成されている。この保護ダイオード1は、その一番外側の層に、A1などの金属膜からなり、ゲート電極パッドと連続的に形成されるゲート配線2がリング状に設けられてコンタクトされ、一番内側の層に、金属膜からなるソース配線3がコンタクトされることにより、ゲートとソース間に接続されていることに特徴がある。

【0014】

前述のように、本発明者らは、縦型MOSFETなどのゲート・ソース間に、サージなどに対する保護ダイオードをただ挿入しても、所望の耐圧が得られず、さらなる耐圧の向上を図るため鋭意検討を重ねた結果、ゲート・ソース間にツェナーダイオードなどの保護ダイオードを挿入する場合に、そのゲート・ソース間の直列抵抗が大きくなると、保護ダイオードを介して放電する前に、ゲート絶縁膜が破壊して、充分にその機能を果たし得ないことを見出した。すなわち、保護ダイオード自身にも直列抵抗を有し、またその接続に半導体層の拡散領域などを介して接続すると、その抵抗分が影響し、その抵抗分により保護ダイオードが充分に機能する前に縦型MOSFETが破損することを見出した。

【0015】

たとえば、保護ダイオードの抵抗分としては、保護ダイオード1を構成するポ

リシリコン膜への不純物濃度や長さ（p n 接合方向の長さ；p n 接合面と直角方向の長さ）、その幅（p n 接合方向に対して直角方向の長さ；p n 接合の面積）により大きく影響を受けることが判明した。ポリシリコン膜への不純物濃度やその長さ（p n 接合方向の長さ）は、保護ダイオードをブレイクダウンさせる電圧にも影響するため、抵抗値を下げる方向のみで設定することはできないが、その幅（p n 接合方向に対して直角方向の長さ）は、ブレイクダウン電圧とは関係なく抵抗のみに影響し、できるだけ大きくすることにより、すなわち p n 接合のリングが大きくなるチップの外周部に形成されることにより、その直列抵抗を下げるることができる。

【0016】

また、同じチップの外周部に保護ダイオード30を形成しても、たとえば図5（a）に示されるように、チップの端部側にソース配線27aが形成されると、ソース配線27aを半導体層の表面に形成されたpウェル31を介して接続しないと、金属膜からなるゲート配線やゲート電極パッド35と同時に形成することができないが、このpウェル31のような拡散領域を経路とすると、拡散領域のシート抵抗は、たとえば $200\Omega/\square$ （ $100\sim1000\Omega/\square$ ）程度であり、ソース・ゲート間の配線抵抗Rは、拡散領域31の接続方向の長さ（図5（a）参照）を $100\mu\text{m}$ 、チップ周囲の長さを $1\text{mm}\times4=4\text{mm}$ 、とすると、 $R=100\mu\text{m}/4\text{mm}\times200\Omega/\square=5\Omega$ （ $2.5\sim25\Omega$ ）となる。

【0017】

すなわち、図5（b）に等価回路図が示されるように、抵抗 $R=5\Omega$ が直列に接続された構造になる。この状態で静電破壊耐量上げるためには、保護ダイオードのブレイクダウン後の抵抗値を 10Ω 程度まで下げなければならず、ブレイクダウン電圧に必要な不純物濃度との関係で、不可能に近くなる。そのため、このような拡散領域を保護ダイオードの接続構造の一部に用いることはできず、抵抗の小さい配線を用いる必要があることを見出した。

【0018】

本発明による保護ダイオード1は、図1（b）にゲート配線2とソース配線3のA1パターンが形成された平面説明図が示されるように、半導体チップの外周

部にリング状に形成されている。図1に示される縦型MOSFETでは、この保護ダイオード1の内周側には、図1(a)に一部が示されているように、たとえばp形のボディ領域5で示されるトランジスタセルがマトリクス状に形成されている。したがって、そのセル活性領域上には設けられないが、セル活性領域（ソース配線3が形成された領域）の外周側には、各セル部での空乏層をできるだけセルから離れた部分で終端させるように、半導体チップの外周部にはある程度のスペースが確保されている。このスペース部分の SiO_2 などからなる絶縁膜6上に、たとえばポリシリコンからなるゲート電極パッドやセル部のゲート電極8を形成すると同時にポリシリコン膜が成膜され、パターニングされると共に、不純物を導入してn形層1aとp形層1bとが交互に配列され、pn接合部が横方向に複数組直列に形成されている。

【0019】

前述のポリシリコン膜は、たとえば $0.5\mu\text{m}$ 程度の厚さに成膜され、たとえば $4\mu\text{m}$ 程度の幅でn形層1aと、p形層1bが交互にリング状に形成されることにより構成されている。このn形層1aおよびp形層1bの不純物濃度は、たとえばそれぞれ $5 \times 10^{20} \text{cm}^{-3}$ 、 $7 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$ 程度に形成され、この不純物濃度とpn接合の数により、所望のブレークダウン電圧が得られるように設定される。n形層1aと、p形層1bとにして保護ダイオード1を形成する方法は、たとえばポリシリコン膜にp形ドーパントが全面にドーピングされた後に、パターニングによりリング状にn形ドーパントが、前述の不純物濃度になるように、ドーピングされることにより、n形層1aとp形層1bとが平面的に交互に繰り返されるようにドーピングされて、双方向のツェナーダイオードが形成される。

【0020】

この保護ダイオード1のブレークダウン電圧は、前述のように、その不純物濃度を調整することにより、ある程度は調整することができ、通常は1個のダイオードで $5 \sim 10 \text{V}$ 程度になるようにその不純物濃度が設定されている。そして、たとえば3～4個程度のpn接合部を形成して $20 \sim 30 \text{V}$ 程度でブレークダウンするような保護ダイオード1が形成される。

【 0 0 2 1 】

この保護ダイオード 1 の最外周の n 形層 1 a には、ゲート配線 2 がコンタクトされている。すなわち、図 1 (a) に示されるように、たとえばポリシリコンからなる保護ダイオード 1 およびトランジスタセルのゲート電極 8 が形成された後、層間絶縁膜 9 が設けられ、保護ダイオード 1 の最外周および最内周にコンタクト孔が開けられ、全面に成膜された A 1 膜をパターニングすることにより、図 1 (b) に示されるように、ゲート電極パッド G と連続して設けられるゲート配線 2 とソース配線 3 が金属膜により形成されている。その結果、保護ダイオード 1 は、共に金属膜配線によりゲートとソースとの間に接続された構造になっている。

【 0 0 2 2 】

トランジスタのセル部は、図 1 (a) に一部が示されるように、たとえば $300\mu\text{m}$ 程度の厚さの n^+ 形半導体基板 4 a 上に比抵抗が $0.1\Omega\cdot\text{cm}\sim\text{数十}\Omega\cdot\text{cm}$ 程度で、厚さが数 $\mu\text{m}\sim\text{数十}\mu\text{m}$ 程度にエピタキシャル成長された n^- 形のエピタキシャル成長層 4 の表面側に p 形ドーパントが導入されてボディ領域 5 がマトリクス状に設けられ、そのボディ領域 5 の外周部に n 形不純物が導入されてソース領域 7 が形成され、ソース領域 7 と n^- 形半導体層 4 とで挟まれるボディ領域 5 の周辺のチャンネル領域上にゲート酸化膜 6 a を介してゲート電極 8 が設けられることにより形成されている。このボディ領域 5 が、前述のようにマトリクス状に設けられ、トランジスタセルが多数個並列接続され、大電流が得られる縦型 MOSFET になっている。

【 0 0 2 3 】

なお、ゲート電極 8 は、前述のように保護ダイオード部 1 と同時にポリシリコン膜を成膜してパターニングし、1 種類のドーパントをドーピングすることにより形成される。このゲート電極 8 上に層間絶縁膜 9 が設けられ、さらにコンタクト孔が開けられ、前述のように、A 1 などが真空蒸着などにより設けられることにより、ソース配線 3 が各トランジスタのソース領域 7 と接続して形成される。また、半導体基板 4 a (図面では他の部分に比して薄く書かれている) の裏面には、同様に電極メタルの蒸着などによりドレイン電極 1 0 が形成される。

【0024】

本発明の半導体装置は、このような構造になっているため、保護ダイオード1は、その面積に相当するpn接合方向と直角方向の長さ（pn接合面積）が半導体チップの外周の長さでほぼ最大の大きさに形成されており、しかもその両端部はA1などの金属膜によりゲートおよびソースと直接接続されている。そのため、ゲート・ソース間の直列抵抗を非常に小さくすることができる。すなわち、金属膜による配線の抵抗は、殆ど0で、前述の拡散領域による経路の有する5Ω程度の抵抗を0にすることができる。その結果、ブレイクダウン電圧を得るための所望の不純物濃度（不純物濃度を低くすることにより空乏層の広がりが大きくなりブレイクダウン電圧が高くなる）にしても、その挿入抵抗を十分に抑えることができ、十分に静電破壊耐量を上げることができ、従来の120V程度の破壊耐量を1000V程度に向上させることができた。

【0025】

さらに、本発明によれば、空乏層の広がりのため、素子形成をすることができない半導体チップ周囲の空きスペースを利用して保護ダイオードが形成されているため、半導体チップ面積を大きくする必要がない。さらに、ゲート配線が保護ダイオードの最外周の層とコンタクトされているため、ゲート配線とソース配線とを同時に形成することができ、製造工程を増やすことなく効果的な保護ダイオードを形成することができる。その結果、使用目的に応じたブレイクダウン電圧を設定しながら、それ以上の静電気やサージなどの印加に対してゲート絶縁膜などの破壊しやすい部分を確実に保護することができる。

【0026】

前述の例は、トランジスタセルが半導体チップの端部側まで形成されていたが、図2に図1(a)と同様の断面説明図が示されるように、一番端部側には、トランジスタセルを形成しないで、ボディ領域と同じ p^+ 形領域11のみを形成しておき、その拡散領域11にもソース配線3をコンタクトさせておくことにより、空乏層の曲率をかせぐことができ、電界集中を避けることができるため、より一層耐圧が向上する。なお、図2において、図1と同じ部分には同じ符号を付してその説明を省略する。

【0027】

つぎに、図2に示される構造の半導体装置の製法を説明する。まず、図3(a)に示されるように、ドレインとなる n^+ 形シリコン基板4aに比抵抗が $0.1 \sim$ 数十 $\Omega \cdot \text{cm}$ 、厚さが数 $\mu\text{m} \sim$ 数十 μm の n 形エピタキシャル成長層4を成長する。そして、数百 nm 程度の酸化膜6を形成し、ボディ領域5および p^+ 形拡散領域11を形成する部分が開口するようにエッチングをし、スルーオキサイド膜16を形成する。その後、 p 形ドーパントであるボロン(B)をイオン注入し、熱処理を行って拡散することにより、 p 形のボディ領域5および p^+ 形拡散領域11を形成する。

【0028】

つぎに、図3(b)に示されるように、活性領域となるセル領域の酸化膜を除去し、ゲート酸化膜6aを形成しゲート電極となるポリシリコン膜8aを成膜する。そして、所望の耐圧の保護ダイオードが得られるような濃度に、たとえばボロン(B)イオンの p 形イオンを注入する。

【0029】

つぎに、図3(c)に示されるように、セル部を形成するため、ゲート電極8が形成されるようにポリシリコン膜8aをパターニングし、ついでそのゲート電極8をマスクとして、たとえばボロンイオンの p 形ドーパントをイオン注入し、熱拡散をすることによりチャネル領域5aを形成する。なお、このイオン注入の際、保護ダイオード部のポリシリコン膜8aにもイオン注入される。このイオン注入の濃度が極端に低い場合は問題ないが、たとえばこのイオン注入がドーズ量 10^{13}cm^{-2} あたりであれば、最初の p 形イオン注入と、このチャネル形成の p 形イオン注入を合計した濃度で保護ダイオード1の耐圧をコントロールする。

【0030】

その後、図4(d)に示されるようなマスク17をホトレジストにより形成し、リン(P)などの n 形イオンを注入し、アニール処理により、ソース領域7を形成する。この際、拡散領域11部には n 形イオンが注入されないようにマスク17で覆うと共に、保護ダイオード部にも、同時に図4(d)に示されるようなマスク17を形成し、同じ n 形イオンを注入してアニール処理をすることにより

、n形層1aとp形層1bからなるpn接合の保護ダイオード1を形成する。

【0031】

その後、図4(e)に示されるように、常圧CVD法により、たとえばPSGからなる層間絶縁膜9を堆積する。そして、パターニングをしてコンタクトホールを形成し、Alなどを蒸着してパターニングをすることにより、金属膜からなるゲート配線2、ゲート電極パッドGおよびソース配線3を形成することにより、図1に示される構造の縦型MOSFETを形成することができる。この際、ゲート配線2は、図1(b)に示されるように、ゲート電極パッドGと連続すると共に、保護ダイオード1の最外層よりも外側まで覆うように、パターニングされて形成される。

【0032】

前述の例は、縦型MOSFETの例であったが、この縦型MOSFETにさらにバイポーラトランジスタが作り込まれる絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)でも同様であり、また、バイポーラトランジスタでもベース・エミッタ間などの破壊を防止するため、電極間に保護ダイオードを接続する場合に、同様にチップの外周側に半導体層のスペースがあり、その上方の絶縁膜上に保護ダイオードを設けることができる。

【0033】

【発明の効果】

本発明によれば、ポリシリコンからなるゲート電極パッドを大きくすることなく、半導体チップの空きスペースを利用して保護ダイオードが形成されると共に、所望のブレークダウン電圧を確保しながら直列抵抗を小さくしているため、非常に大きな静電破壊耐量を得ることができる。その結果、小さな半導体チップでセルが多く高特性で、かつ、静電破壊耐量に強い、非常に信頼性の高い半導体装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の半導体装置の一実施形態である縦型MOSFETの断面および平面の説明図である。

【図 2】

図 1 の縦型 MOSFET の変形例を示す断面説明図である。

【図 3】

図 2 の例の製造工程を説明する図である。

【図 4】

図 2 の例の製造工程を説明する図である。

【図 5】

保護ダイオードの接続が、半導体層の拡散領域を介して行われる場合の問題を説明する図である。

【図 6】

従来の保護ダイオードが設けられた縦型 MOSFET の断面および平面の説明図である。

【図 7】

図 6 の保護ダイオードが設けられた電極パッドの説明図である。

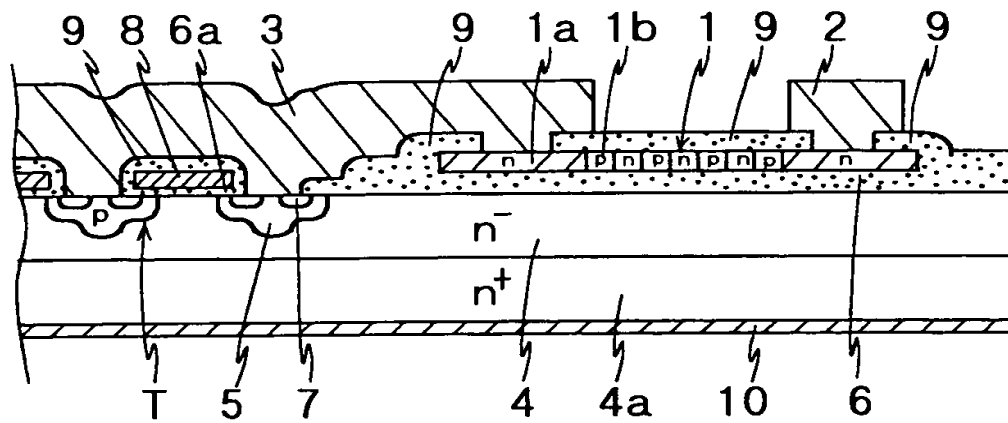
【符号の説明】

- 1 保護ダイオード
- 2 ゲート配線
- 3 ソース配線
- 4 半導体層
- 5 ボディ領域

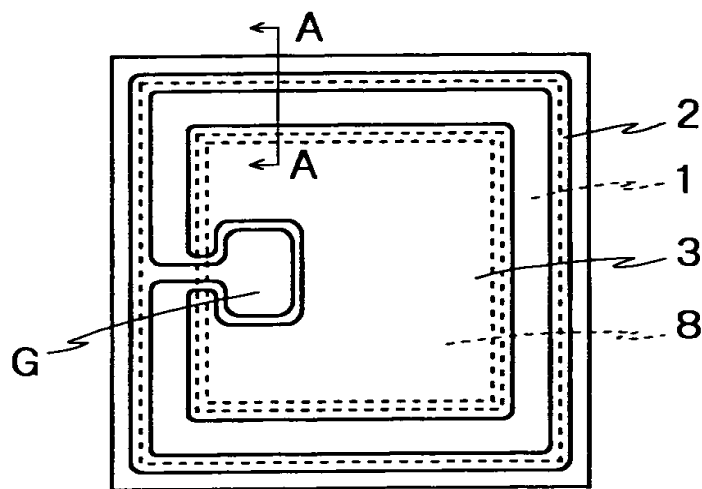
【書類名】 図面

【図 1】

(a)

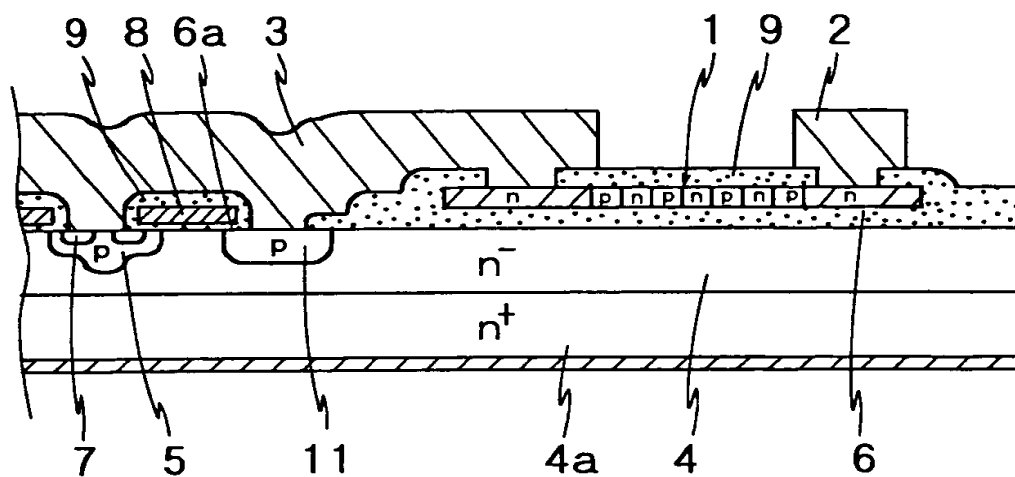


(b)

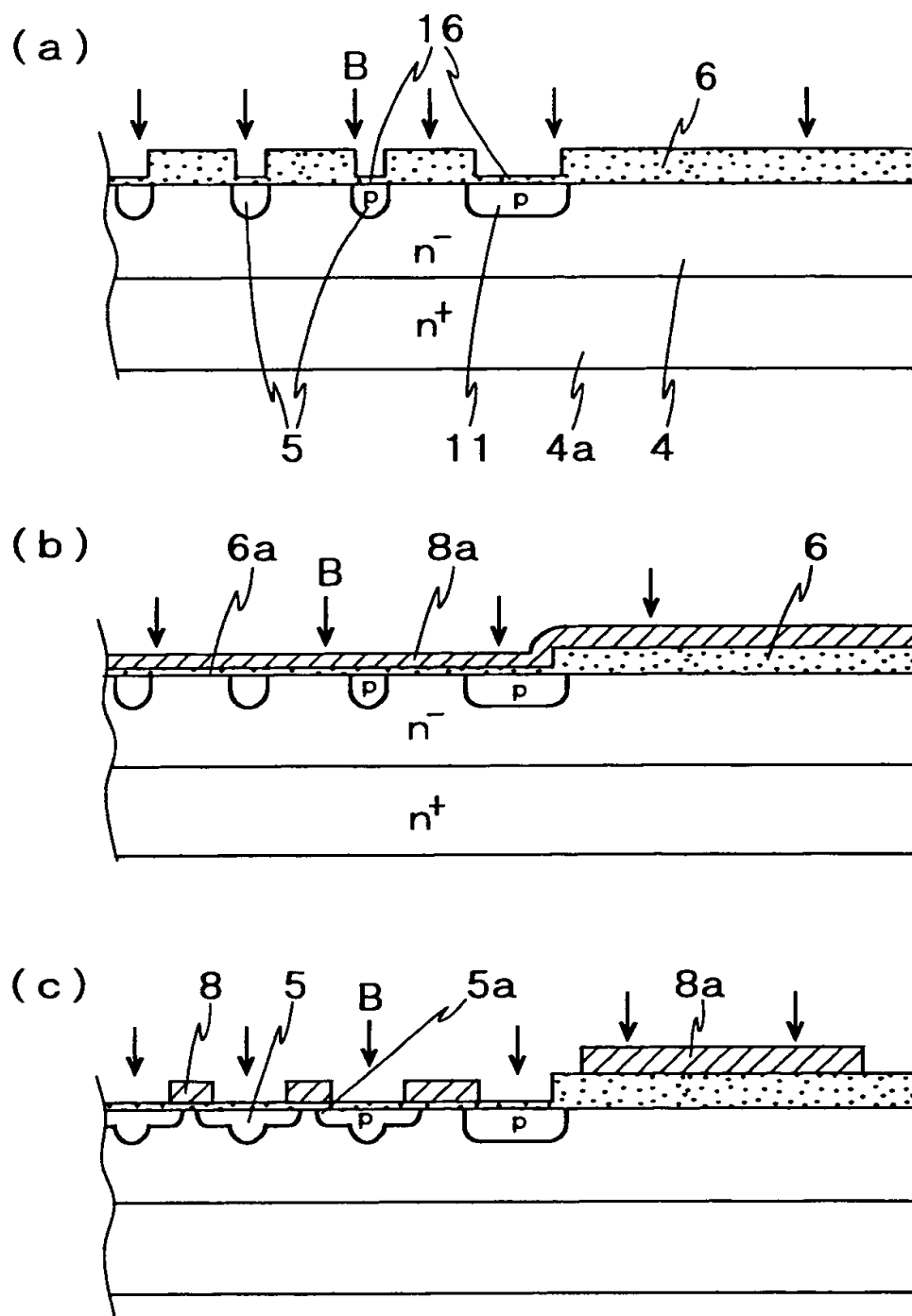


- | | |
|-----------|---------|
| 1 保護ダイオード | 4 半導体層 |
| 2 ゲート配線 | 5 ボディ領域 |
| 3 ソース配線 | |

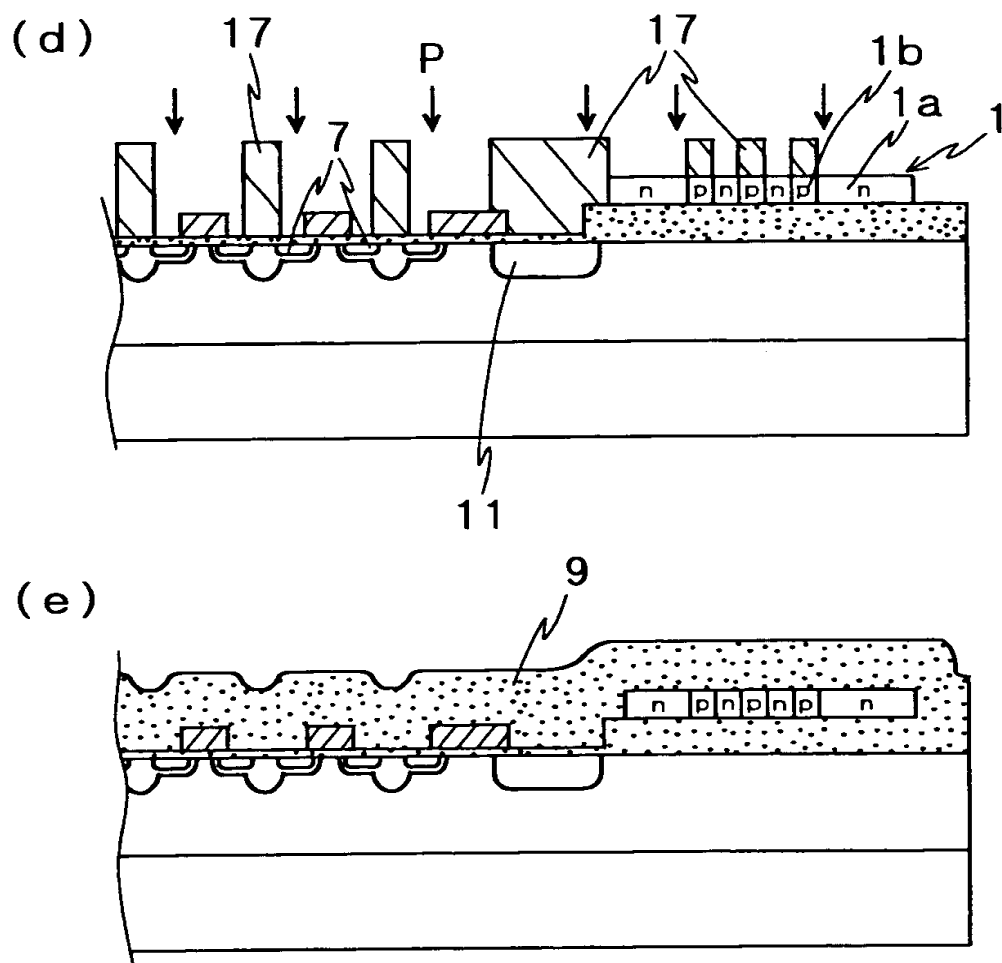
【图 2】



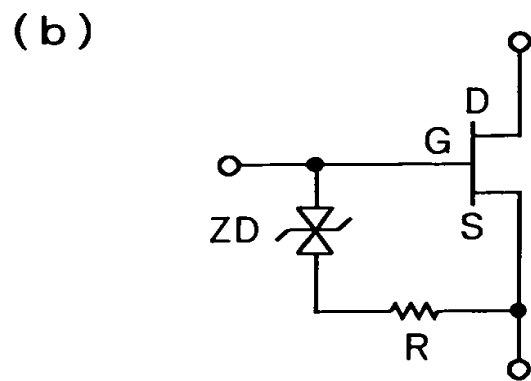
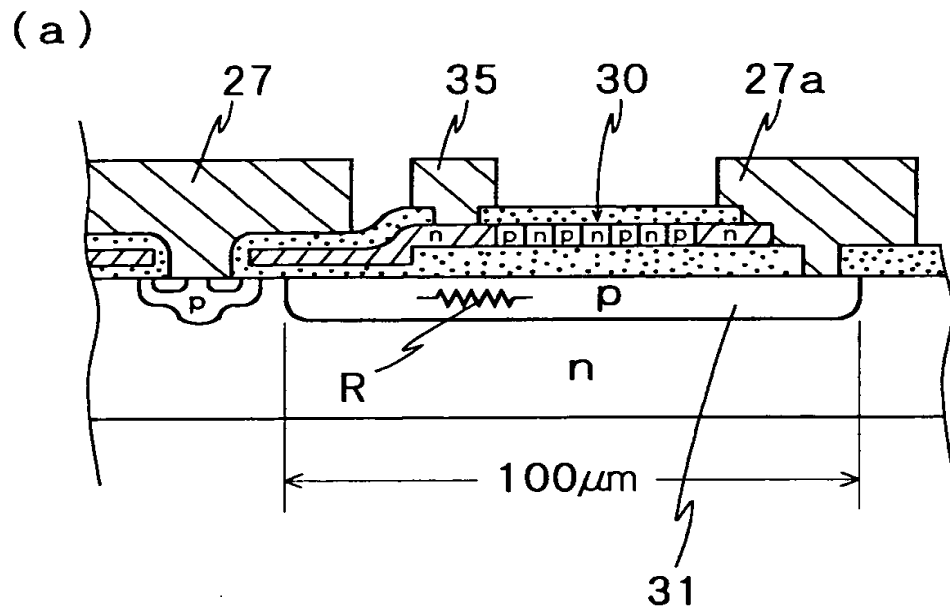
【図3】



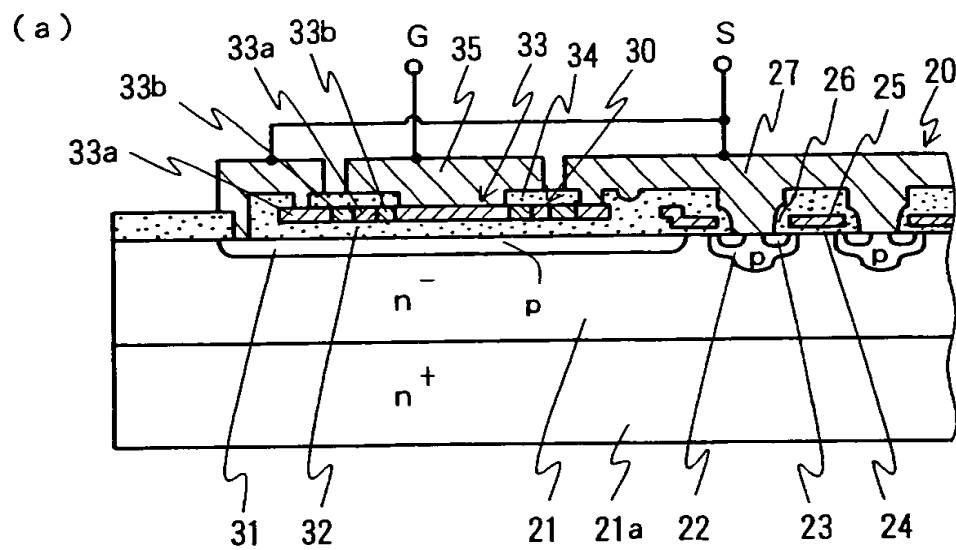
【図4】



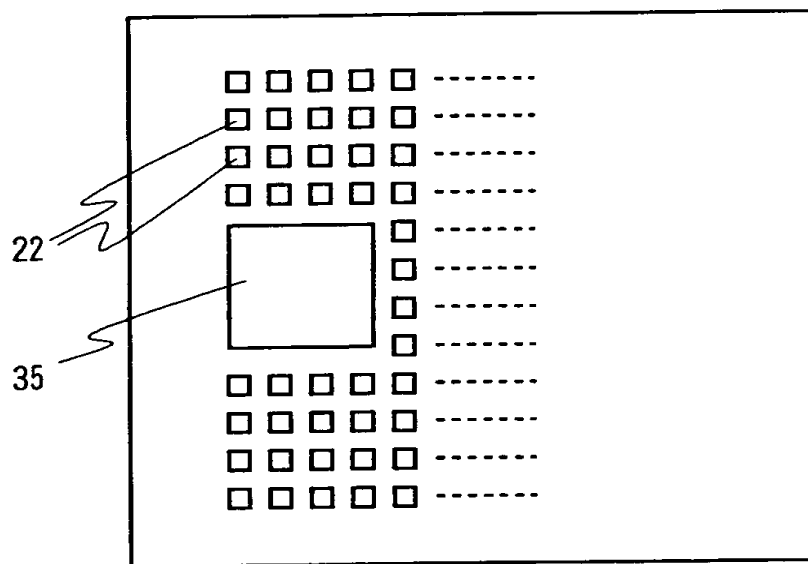
【図 5】



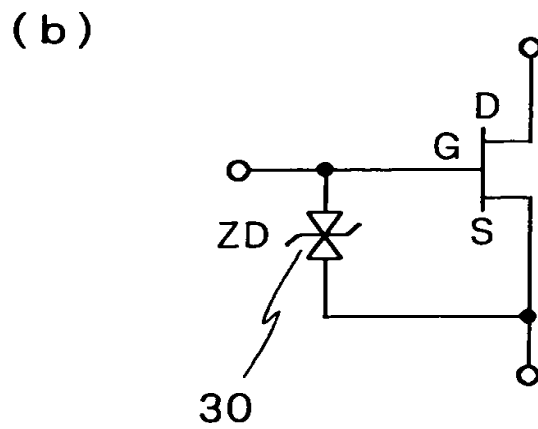
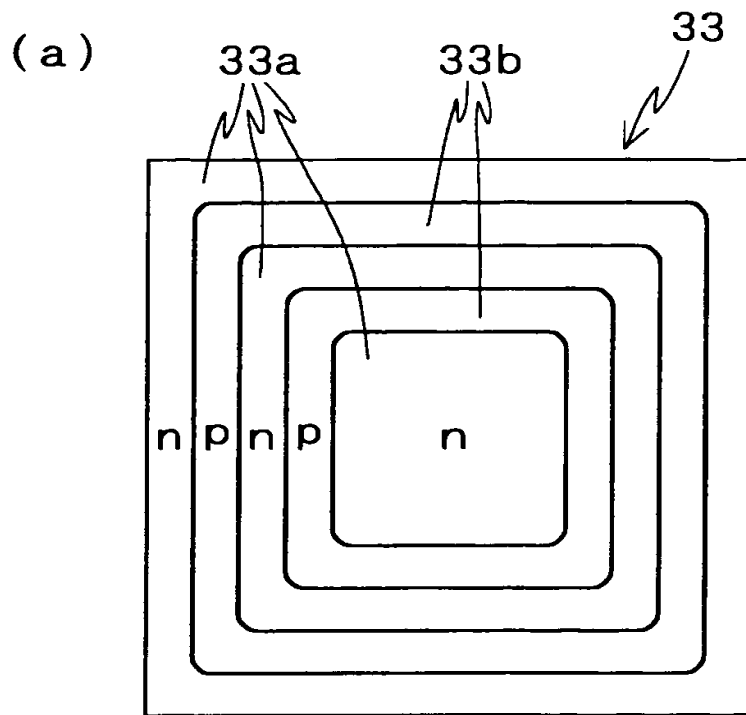
【図 6】



(b)



【図 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 チップ面積を大きくすることなく、チップの空いている外周部分を利用しながら、直列抵抗が小さく、かつ、十分に保護機能を果たすことができる保護ダイオードを有する半導体装置を提供する。

【解決手段】 半導体層 4 に複数のトランジスタセル T が配列されて形成されている。その複数のトランジスタセル T より外周側（チップ端部側）の絶縁膜 6 上にポリシリコン膜によるリング状の p 形層 1 b と n 形層 1 a とが交互に設けられることにより、保護ダイオード 1 が形成されている。この保護ダイオード 1 は、その一番外側の層に、A 1 などの金属膜からなるゲート配線 2 がリング状に設けられてコンタクトされ、一番内側の層に、金属膜からなるソース配線がコンタクトされることにより、ゲートとソース間に接続されている。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000116024]

1. 変更年月日 1990年 8月22日

[変更理由] 新規登録

住 所 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地
氏 名 ローム株式会社

